This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representation of The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PAT-NO:

JP406020227A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06020227 A

TITLE:

MANUFACTURE OF THIN-FILM MAGNETIC HEAD

PUBN-DATE:

January 28, 1994

INVENTOR-INFORMATION: NAME TOYODA, ATSUSHI SAWADA, SHUICHI

INT-CL (IPC): G11B005/31

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent that an undercut is produced at the edge of a non-pole part when the non-pole part is formed and to prevent that a void (an empty part, a crack) is caused when a protective layer is formed on it by a sputtering operation in an upper-core separated component type thin-film magnetic head.

CONSTITUTION: A coil layer, an insulating layer and, in addition, a pole-part upper-part magnetic layer 32 are formed; in addition, a plated substratum metal layer 40 is formed. Then, a negative resist 60 is coated; a mask 58 is applied; parts other than a part where a non-pole upper-part magnetic layer is to be formed are exposed. The part which is not to be exposed is not irradiated with reflected light 46 from a stepped slope 56. Then, the resist in the part which has not been irradiated with the light is developed and removed; a resist frame 60 is formed. The non-pole-part upper-part magnetic layer 32b is electroplated on the plated substratum metal layer 40 which has been exposed; after that, the resist frame 60' is removed. After that, a protective film 30 is formed by a sputtering operation; a substrate is cut; a slider 49 is formed.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio

----- KWIC -----

Abstract Text - FPAR (2):

CONSTITUTION: A coil layer, an insulating layer and, in addition, a pole-part upper-part magnetic layer 32 are formed; in addition, a plated substratum metal layer 40 is formed. Then, a negative resist 60 is coated; a mask 58 is applied; parts other than a part where a non-pole upper-part magnetic layer is to be formed are exposed. The part which is not to be exposed is not irradiated with reflected light 46 from a stepped slope 56. Then, the resist in the part which has not been irradiated with the light is

developed and removed; a resist frame 60 is formed. The non-pole-part upper-part magnetic layer 32b is electroplated on the plated substratum metal layer 40 which has been exposed; after that, the resist frame 60' is removed. After that, a protective film 30 is formed by a sputtering operation; a substrate is cut; a slider 49 is formed.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-20227

(43)公開日 平成6年(1994)1月28日

(51)Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 1 1 B 5/31

A 7247-5D

H 7247-5D

審査請求 未請求 請求項の数1(全 6 頁)

(21)出願番号

特願平4-201985

(71)出願人 000004075

ヤマハ株式会社

静岡県浜松市中沢町10番1号

(22)出顧日

平成 4年(1992) 7月 3日

(72)発明者 豊田 篤志

静岡県浜松市中沢町10番1号 ヤマハ株式

会社内

(72)発明者 沢田 修一

静岡県浜松市中沢町10番1号 ヤマハ株式

会社内

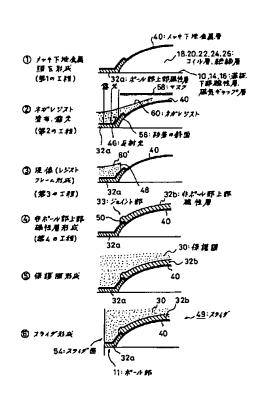
(74)代理人 弁理士 加藤 邦彦 (外1名)

(54) 【発明の名称】 薄膜磁気ヘッドの製造方法

(57)【要約】

【目的】 上コア分離コンポーネント型の薄膜磁気へッドにおいて、非ポール部形成時に非ポール部端面にアンダーカットが生じるのを防止して、その上にスパッタリングで保護層を形成する際にボイド(空所、割れ目)が発生するのを防止する。

【構成】 ①コイル層および絶縁層さらにはポール部上部磁性層32aを形成した上にメッキ下地金属層40を形成する。②ネガレジスト60を塗布し、マスク58を当てて、非ポール部上部磁性層を形成する部分以外を露光する。段差の斜面56からの反射光46は露光すべきでない部分には照射されない。③現像して光が当たらなかった部分のレジストを除去してレジストフレーム60′を作る。④露出したメッキ下地金属層40上に非ポール部上部磁性層32bを電気メッキした後レジストフレーム42′を除去する。⑤保護膜30をスパッタで形成する。⑤基板をカットしてスライダ40を形成する。



10

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】基板上に下部磁性層、磁気ギャップ層および複数の導体コイルとこの導体コイルを保護する非磁性 絶縁層を順次積層し、さらにポール部および前記導体コイルと非磁性絶縁層の積層による段差の斜面にかけてポール部上部磁性層を形成し、その後前記段差上に前記ポール部上部磁性層とつながった状態に非ポール部上部磁性層を形成し、その上に全体に保護膜をスパック法で形成して薄膜磁気ヘッドを製造する方法であって、

前記非ポール部上部磁性層を形成する工程が、

前記ポール部上部磁性層および前記非磁性絶縁層にかけてメッキ下地金属膜を形成する第1の工程と、

このメッキ下地金属膜の上にネガレジストを塗布する第2の工程と、

このネガレジストの前記非ポール部上部磁性層を形成する部分以外を露光し、現象処理して当該非ポール部上部 磁性層を形成する部分のレジストを除去する第3の工程 と、

このレジスト除去で露出した前記メッキ下地金属膜上に前記非ポール部上部磁性層を電気メッキで形成しその後 20 残りのレジストを除去する第4の工程とからなることを特徴とする薄膜磁気ヘッドの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、上部磁性層をポール部と非ポール部に分けて別々に形成するいわゆる上コア分離コンポーネント型の薄膜磁気ヘッドに関し、非ポール部形成時に非ポール部端面にアンダーカットが生じるのを防止して、その上にスパッタリングで保護層を形成する際にボイド(空所、割れ目)が発生するのを防止し 30 たものである。

[0002]

【従来の技術】薄膜磁気ヘッドは固定磁気ディスク等の磁気ディスク装置の記録および読出手段として用いられている。薄膜磁気ヘッドは、一般にスライダ基板上に下部磁性層(下コア)、ギャップ層、複数の導体コイルおよび非磁性絶縁層、上部磁性層、保護層を順次積層して構成される。従来の上部磁性層の形成工程は、導体コイルおよび非磁性絶縁層が積層された上にレジストで上部磁性層全体の型(レジストフレーム)を作り、この型内 40に磁性金属を電気メッキして上部磁性層全体を一度に作っていた。

【0003】ところが、導体コイルおよび非磁性絶縁層が積層された状態では基板上に大きな段差が生じており、この状態で上部磁性層を形成するためにレジストをスピンコート等で塗布すると、レジストは低い所に多く溜まるため、段差の下のボール部を形成するところではレジスト塗厚が厚くなり、段差の上の非ボール部を形成するところではレジストの塗厚が薄くなる。そして、ボール部を形成するところのレジスト途厚が厚いとボール

部のポール幅を高精度に形成できない問題がある。レジ スト塗厚を全体的に薄く塗布すれば、段差の下の塗厚は

スト
塗厚を全体的に薄く塗布すれば、段差の下の塗厚は 薄くなるが、今度は段差の上の塗厚が薄くなりすぎてレ ジストフレーム切れを起こしやすくなり、非ポール部が 正しい形に形成されなくなる。

2

【0004】また、ポール部の厚みは記録再生上の特性面から決定されるのに対し、非ポール部の厚みは非ポール部での磁気飽和を避けてスロートハイトゼロ位置の近傍で磁気飽和を生じさせるために、また上部磁性層全体の磁気抵抗を下げるためにポール部より厚く形成する必要がある。ところが、前記従来の上部磁性層全体を一度に作る方法ではポール部と非ポール部の厚さを異ならせることはできなかった。

【0005】そこで、従来方法および上述した問題点を解決する方法として、いわゆる上コア分離コンポーネント型と称して、上部磁性層をポール部と非ポール部に分けて別々に形成する方法が提案されていた。図2は上コア分離コンポーネント型薄膜磁気へッドの一例を示したものである。

【0006】この薄膜磁気ヘッド1は、鏡面研磨された清浄なスライダ基板10として、例えばA1 $_2$ O $_3$ -T i系セラミック板等を有し、この基板10上にはスパッタ法によりSiО $_2$, A1 $_2$ O $_3$ 等の下地膜(図示せず)が10数 $_\mu$ m付着され、その上に下部磁性層14が電気メッキにより積層されている。下部磁性層14の上には磁気ギャップ層16がスパッタ法により積層されて、磁気ギャップ17を形成している。磁気ギャップ層16は例えば保護膜と同様にSiО $_2$, A1 $_2$ O $_3$ 等で作られている。

【0007】磁気ギャップ層16上には第1絶縁層18が積層されている。絶縁層には通常、ボジ型のホトレジストが用いられ、熱処理を加えて安定に硬化されている。第1絶縁層18の上には、第1コイル層20がCu等で電気メッキにより数μmの厚さに形成されている。第1コイル層20の上には、さらに同様の方法で第2絶縁層22、第2コイル層24、第3絶縁層26が順次積層されている。この積層により基板10上には大きな段差が生じる。

【0008】第3絶縁層26の上には上部磁性層32が電気メッキにより形成されている。上部磁性層32は段差下13のポール部11にポール部上部磁性層32aを形成した後に段差上15に非ポール部上部磁性層32bを形成して構成され、これら両部分32a、32bはジョイント部33で相互につながれて一体化されている。非ポール部上部磁性層32bの後部は、下部磁性層14と接合されている。上部磁性層32の上には、保護膜30がSiO2、Al2 O3等でスパッタ法により積層されて、全体を覆っている。

するところではレジストの塗厚が薄くなる。そして、ポ 【0009】上部磁性層32は、はじめにレジストでポール部を形成するところのレジスト塗厚が厚いとポール 50 一ル部上部磁性層32aの型を作って電気メッキにより

ポール部上部磁性層32aを作り、その後レジストを除 去して、新たにレジストでポール部上部磁性層32aと 一部重複するように非ポール部上部磁性層32bの型を 作って電気メッキにより非ポール部上部磁性層32bを 作って構成される。

【0010】従来における非ポール部上部磁性層32b の形成工程を図3を参照して説明する。

- ① コイル層および絶縁層18,20,22,24,2 6を積層し、さらに下部磁性層と同じ材料として例えば パーマロイ等でポール部上部磁性層32aを形成した上 10 に全体にパーマロイ等のメッキ下地金属層40をスパッ 夕法で形成する。
- ② ポジレジスト42をスピンコート等で塗布し、マス ク44を当てて、非ポール部上部磁性層32bを形成す る部分を露光する。
- 現像して光が当たった部分のレジストを除去してレ ジストフレーム42′を作る。
- 郵出したメッキ下地金属層40上にパーマロイ等を 電気メッキして非ポール部上部磁性層32bを形成した 後レジストフレーム42′を除去する。
- ⑤ SiO₂, Al₂O₃等をスパッタして保護膜30 を形成する。
- ⑤ 基板10をカットしてスライダ49を形成する。 [0011]

【発明が解決しようとする課題】従来においては、上部 磁性層32を形成するためのレジスト42には解像度の よいポジレジストが用いられていた。ところが、図3② のようにポジレジスト42を塗布して非ポール部上部磁 性層32bを形成する部分を露光すると、段差の斜面5 6でメッキ下地金属膜40に当たって反射された反射光 30 46が本来残すべきレジスト部分に照射されるため、レ ジストフレーム42~の端面48が垂直に形成されず に、図3〇のに示すように斜めに形成されてしまう。

【0012】このため、そのレプリカとしての非ポール 部上部磁性層32bの端面50が図3Φのようにアンダ ーカットされた形状となる。このような形状では、図3 **⑤**の保護膜30をスパッタする時に、アンダーカット部 の下からボイド52(空所、割れ目)が成長する。そし て、図36のスライダ49を形成した時にこのボイドラ 2がスライダ面54に現われ、スライダの浮上特性を害 40 することになる。

【0013】この発明は、上述の点に鑑みてなされたも ので、非ポール部上部磁性層の形成時にその端面にアン ダーカットが生じるのを防止して、その上にスパッタリ ングで保護層を形成する際にボイドが発生するのを防止 した薄膜磁気ヘッドを提供しようとするものである。

[0014]

【課題を解決するための手段】この発明は、非ポール部 上部磁性層を形成する工程が、ポール部上部磁性層およ

1の工程と、このメッキ下地金属膜の上にネガレジスト を塗布する第2の工程と、このネガレジストの前記非ポ ール部上部磁性層を形成する部分以外を露光し、現象処 理して当該非ポール部上部磁性層を形成する部分のレジ ストを除去する第3の工程と、このレジスト除去で露出 した前記メッキ下地金属膜上に前記非ポール部上部磁性 層を電気メッキで形成しその後残りのレジストを除去す る第4の工程とからなることを特徴とするものである。 [0015]

【作用】この発明によれば、従来解像度の点からポジレ ジストが用いられていたのに代えて、ネガレジストを用 いて非ポール部上部磁性層を形成する部分以外を露光す るようにしたので、段差の斜面でメッキ下地金属膜に当 たって反射される反射光は残すべきレジスト部分(すな わち露光すべき部分)に照射され、除去すべき部分(す なわち露光すべきでない部分)には照射されなくなり、 これを現像するとレジストフレームの端面は基板面に対 して略々垂直に形成される。したがって、そのレプリカ としての非ポール部上部磁性層の端面も略々垂直に形成 20 されてアンダーカットが防止されるので、その上に保護 膜をスパッタした時のボイドの発生が防止される。これ により、スライダを形成したときにスライダ面全体が平 滑に形成され、良好な浮上特性が確保される。

[0016]

【実施例】この発明の一実施例を以下説明する。ここで は、前記図2の薄膜磁気ヘッド1を製造する場合につい て示す。図1はこの発明の一実施例を示す工程図で、前 記図3の従来方法と対比される形で示している。図1の 工程について説明する。

- ① 基板、下部磁性層、磁気ギャップ層10,14,1 6上にコイル層および絶縁層18,20,22,24, 26を積層し、さらに下部磁性層と同じ材料として例え ばパーマロイ等でポール部上部磁性層32aを形成した 上に全体にパーマロイ等のメッキ下地金属層40をスパ ッタ法で形成する。ポール部上部磁性層32aを形成す る時のレジストは解像度のよいポジレジストを用いるこ とにより、ポール幅等を高精度に形成することができ る。
- ② ネガレジスト60をスピンコート等で塗布し、マス ク58を当てて、非ポール部上部磁性層を形成する部分 以外を露光する。
 - 現像して光が当たらなかった部分のレジストを除去 してレジストフレーム60、を作る。
 - ④ 露出したメッキ下地金属層40上にパーマロイ等を 電気メッキして非ポール部上部磁性層32bを形成した 後レジストフレーム60′を除去する。
 - ⑤ SiO₂ , Al₂ O₃ 等をスパッタして保護膜30 を形成する。
- び非磁性絶縁層にかけてメッキ下地金属膜を形成する第 50 【0017】以上の工程によれば、図12のようにネガ

5

レジスト60を塗布して非ポール部上部磁性層32bを 形成する部分以外を露光するので、段差の斜面56でメ ッキ下地金属膜40に当たって反射された反射光46は 残すべきレジスト部分(すなわち露光すべき部分)に照 射され、除去すべき部分(すなわち露光すべきでない部 分)には照射されないため、レジストフレーム60′の 端面48は図1〇のに示すように基板10に対して垂直に 形成される。

【0018】したがって、そのレプリカとしての非ポール部上部磁性層32bの端面50も図1ののようにアン 10 ダーカットを生じることなく垂直に形成される。したがって、図1のの保護膜30をスパッタする時に、前記図2のようにボイド52が生じることがなく、図1ののようにスライダ49を形成した時にスライダ面54を平滑に形成することができ、スライダ49は安定した浮上特性を得ることができる。

[0019]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれば、従来解像度の点からポジレジストが用いられていたのに代えて、ネガレジストを用いて非ポール部上部磁性 20 層を形成する部分以外を露光するようにしたので、段差の斜面でメッキ下地金属膜に当たって反射される反射光は残すべきレジスト部分(すなわち露光すべき部分)に照射され、除去すべき部分(すなわち露光すべきでない部分)には照射されなくなり、これを現像するとレジストフレームの端面は基板面に対して略々垂直に形成される。したがって、そのレプリカとしての非ポール部上部

磁性層の端面も略々垂直に形成されてアンダーカットが 防止されるので、その上に保護膜をスパッタした時のボ イドの発生が防止される。これにより、スライダを形成 したときにスライダ面全体が平滑に形成され、良好な浮

6

上特性が確保される。 【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の一実施例を示す工程図である。

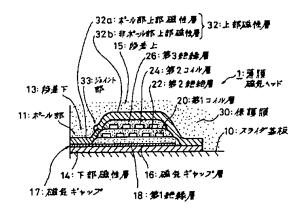
【図2】 上コア分離コンポーネント型薄膜磁気ヘッドを示す断面図である。

10 【図3】 従来方法を示す工程図である。

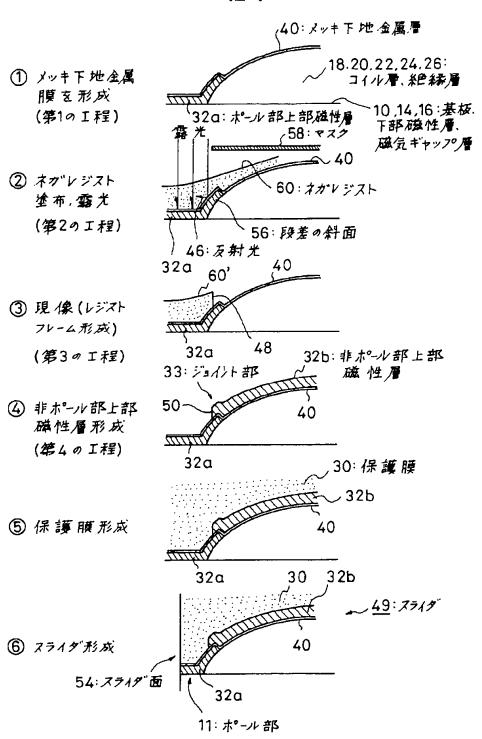
【符号の説明】

- 10 基板
- 11 ポール部
- 13 段差下
- 14 下部磁性層
- 15 段差上
- 16 磁気ギャップ層
- 18, 22, 26 絶縁層(非磁性絶縁層)
- 20,24 コイル層(導体コイル)
- 0 30 保護膜
 - 32 上部磁性層
 - 32a ポール部上部磁性層
 - 32b 非ポール部上部磁性層
 - 40 メッキ下地金属層
 - 56 段差の斜面
 - 60 ネガレジスト

【図2】



【図1】



【図3】

